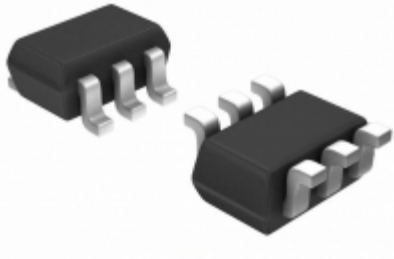









	<h2 style="color: #C00000;">SI1922EDH-T1-GE3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI1922EDH-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SOT-363
	Datenblätter:  SI1922EDH-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 53671 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1922EDH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SOT-363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	53671 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 1.3A 1.25W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.25W
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	198 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.5nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	SI1922
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1922EDH-T1-GE3CT

SI1922EDH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1922EDH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1922EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1922EDH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SI19190CTG64 SILICON SILICON QFP64</p>	 <p>SI1926DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SC-70-6</p>	 <p>SI1917EDH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 1A SC70-6</p>	 <p>SI1926DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SC-70-6</p>
 <p>SI1917EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 1A SC70-6</p>	 <p>SI1926A Vishay Precision Group SI1926A VISHAY</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SI19190CT64 SILICON SI19190CT64 SILICON</p>	 <p>SI1926DL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SOT363</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI1905BDH-T1-E3	↔ SI1905BDH-T1-GE3	⇒ SI1905BDH-TI-E3	D SI1905DL	⇒ SI1905DL-T1
⊖ SI1905DL-T1-E3	⊕ SI1905DL-T1-E3	D SI1905DL-T1-GE3	⇒ SI1906DL-T1	⇒ SI1912EDH
⊕ SI1912EDH-T1	⊖ SI1912EDH-T1-E3	⊕ SI1912EDH-T1-E3	↔ SI1912EDH-T1-GE3	⇒ SI1913DH-T1-E3
D SI1913DH-T1-E3	⊕ SI1913DH-T1-GE3	⊖ SI1913EDH-T1	⊕ SI1913EDH-T1-E3	⇒ SI1913EDH-T1-E3
⇒ SI1913EDH-T1-GE3	↔ SI1917EDH-T1	⊕ SI1917EDH-T1-E3	⊖ SI1917EDH-T1-E3	⇒ SI1917EDH-T1-GE3
↔ SI1922EDH-T1-GE3	⇒ SI1926DL-T1-E3	D SI1926DL-T1-E3	⊕ SI1926DL-T1-GE3	⊖ SI1926DL-T1-GE3
⊕ SI1958DH-T1-E3	D SI1958DH-T1-E3	⇒ SI1965DH-E3	↔ SI1965DH-T1-E3	⇒ SI1965DH-T1-E3
⊖ SI1965DH-T1-GE3	⊕ SI1965DH-T1-GE3	↔ SI1967DH-T1-E3	⇒ SI1967DH-T1-E3	⇒ SI1967DH-T1-GE3
⊕ SI1967DH-T1-GE3	⊖ SI1969DH-E3	⊕ SI1970DH-T1-GE3	D SI1970DH-T1-GE3	⇒ SI1972DH-T1
↔ SI1972DH-T1-E3	⊕ SI1972DH-T1-E3	⊖ SI1972DH-T1-GE	⊕ SI1972DH-T1-GE3	⇒ SI1972DH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited